ВІДГУК

на автореферат дисертації Оліха Олега Ярославовича «Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структурах», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла

Дисертаційна робота Олега Ярославовича Оліха охоплює широке коло задач, які стосуються розробки фізичних основ модифікації дефектної структури поверхнево-бар'єрних кремнієвих та арсенід-галієвих структур за допомогою акустичних хвиль та нейтронно— і гамма- опромінення. Актуальність та вагомість дисертації підкреслює список з 25 наукових статей, які опубліковані у високо рейтингових провідних журналах світу.

Автором дисертації **вперше проведені** дослідження низки фундаментальних процесів електропереносу та рекомбінації нерівноважних носіїв заряду для різних поверхнево-бар'єрних структур в умовах керованих змін системи дефектів решітки кристала, як за допомогою нейтронного та уопромінення, так і акустичного навантаження.

До найбільш вагомих наукових результатів дисертації слід віднести:

- 1. Запропонована модель акусто-активного комплексного дефекту в напівпровідниках.
- 2. Проведена схема оптимізації методів визначення параметрів діодів Шотки дозволила не тільки підтвердити достовірність отриманих результатів, але може бути використана в процесі розробок металнапівпровідникових пристроїв і для інших напівпровідникових структур.
- 3. Виявлений ефект немонотонного збільшення величини зворотного струму при зростанні дози у–квантів запропоновано використовувати для оцінки дози, в якості сенсора у–опромінення.
- 4. Виявлення нових ефектів, зокрема, акусто-стимульовану термоелектричну емісію електронів з пасток.
- 5. Експериментально досліджено вплив ультразвукової обробки на параметри структури $Au-TiB_x-n-n^+-GaAs$ з контактом Шотткі залежно від частоти та інтенсивності акустичних хвиль. Виявлено, що, внаслідок акустостимульованої дифузії дефектів при допороговій інтенсивності (менше 2,5 Bt/cm^2) ультразвука відбувається збільшення однорідності параметрів арсенід-галієвих діодів Шотткі.

До дисертаційної роботи ε окремі зауваження, зокрема:

Висновки дисертації були б більш вагомими, якби додатково були проведені дослідження структурних змін у поверхневих шарах системи Au—TiB_x—n—n⁺—GaAs з (або без) контактом Шотткі методами високороздільної X-променевої дифрактометрії.

В цілому, дисертаційна робота О.Я. Оліха є завершеною працею, в якій проблема встановленні основних наукова ПО розв'язана успішно ультразвукового фізичних механізмів закономірностей впливу та струму проходження опромінення процеси навантаження на та Дисертація структурах. поверхнево-бар'єрних напівпровідникових

відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», а її автор, Оліх О. Я. заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла.

Доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики твердого тіла Інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук

Фодчук І.М.

Підпис Фодчука І.М.

«Засвідчую» освіти Вчений секретар Чернівецького національного міверситеть з імені Юрія Фельковича

Mery

luftok baa H.O.